

КТС622А, КТС622Б

Кремниевые эпитаксиально-планарные PNP-транзисторные матрицы предназначены для работы в быстродействующих импульсных и других схемах.

Корпус металлокерамический, герметичный, с гибкими выводами

Параметры	Обозначение	Норма
Статический коэффициент передачи тока	$B1-2/I_k$ /мА	30-150/200
Предельная частота коэффициента передачи тока	F_T МГц	200
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте	$R_b^*C_k$ псек	120
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($U_{кэ}$) биполярного транзистора при заданном токе коллектора (I_k) и заданном токе базы (I_b)	$U_{кэ}/(I_k/I_b)$ В/(мА/мА)	1.3(400/80)
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база	$U_{кб}$ В	45
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер ($U_{кэ}$) при заданной величине сопротивления, включенного между базой и эмиттером (R)	$U_{кэ}/R$ В/Ом	45/1к
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база	$U_{эб}$ В	4
Предельно допустимый постоянный ($I_{км}$) ток коллектора предельно допустимый ток коллектора в режиме насыщения ($I_{кн}$)или в импульсе	$I_{км}/I_{кн}$ А/А	0.4/0.6
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на транзисторе без теплоотвода (P_k) и с теплоотводом (P_T).	P_k/P_T Вт/Вт	0.4/
Тепловое сопротивление перехода коллектор-корпус транзистора	$R_{пк} C/V_T$	218с